



「Si、SiC、GaN におけるバルク結晶成長の基礎～最前線」

◇ 日時: 2026 年 2 月 5 日(木) 13:00～18:00

◇ 場所: プラザエフ カトレア(7F)(四ツ谷) <https://plaza-f.or.jp/>

GX化推進が急務となる中、パワーデバイスへの要求は一層高まっている。本企画では、デバイス性能を左右する重要な要素である「バルク」に着目し、Si・SiC・GaNのバルク結晶成長技術について基礎から学び直すとともに、最新の技術トレンドや将来の展望について議論する。また、パワーデバイス業界では、米中対立の影響により、中国におけるデバイスおよび材料の内製化がかつてないスピードで進展している。そうした中でも、日本が一定の地位を維持しているのがSiウェーハ製造であり、その背景にも焦点を当てながら議論を深める。さらに、SiCやGaNといった次世代材料の現状や課題についても俯瞰的に取り上げ、産業構造の変化を多面的に捉える場としたい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ プ ロ グ ラ ム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

13:00～13:05 開会挨拶

13:05～13:50 昇華法による SiC 単結晶の量産技術開発

百瀬 賢治 (レゾナック)

13:50～14:35 超高品質 SiC 単結晶成長から 20 年

——昇華法の再構築と超高効率大型結晶成長への挑戦

中村 大輔 (豊田中研)

14:35～15:20 Na フラックス法と OVPE 法による GaN 結晶育成の現状と展望

森 勇介 (大阪大学)

15:20～15:40

休 憩

15:40～16:25 GaN 基板開発の最新状況

磯 憲司 (三菱ケミカル)

16:25～17:10 半導体シリコン結晶ウェーハ分野において、なぜ日本が強みを発揮できるのか

泉妻 宏治 (グローバルウェーハズ・ジャパン)

17:10～17:55 Si、SiC、GaN 結晶へのメッセージ

西澤 伸一 (九州大学)

17:55～18:00 閉会挨拶

・・

■参加受付: WEB 参加受付システム([ここをクリック](#)*)から参加登録と参加費のオンライン決済をお願いします。席数に限りがあるため早期に参加受付を終了することがあります。なお、当日の資料は PDF 版となります。

*本案内が印刷物の場合、<https://annex.jsap.or.jp/adps/pdf/kenkyuukai31.pdf> よりアクセスして下さい。

■参 加 費: (消費税込)

先進パワー半導体分科会会員* 4,000 円、分科会学生会員 無料、一般 6,000 円、一般学生 1,000 円

*先進パワー半導体分科会賛助会員所属の方は先進パワー半導体分科会会員扱いとします。

■現地開催におけるご協力をお願い: 発熱がある場合は当日のご参加はご遠慮下さい。会場でのマスクの着用は任意とします。

問合せ先:

中川 聡子 (グローバルウェーハズ・ジャパン) e-mail: Satoko_Nakagawa@sas-globalwafers.co.jp

金村 高司 (ミライズテクノロジーズ) e-mail: takashi.kanemura.j4y@mirise-techs.com

三谷 武志 (産総研) e-mail: t-mitani@aist.go.jp

白石 陽子 (応用物理学会事務局) e-mail: shiraishi@jsap.or.jp